CLIPPEDIMAGE= JP411080852A

PAT-NO: JP411080852A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11080852 A

TITLE: PRODUCTION OF TIN WITH LOW ALPHA-RAY DOSE

PUBN-DATE: March 26, 1999

INVENTOR-INFORMATION: NAME OOMURA, TOSHIMASA MAKI, KAZUMASA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MITSUBISHI MATERIALS CORP

N/A

APPL-NO: JP09236883

APPL-DATE: September 2, 1997

INT-CL_(IPC): C22B025/08; B23K035/40; C23C014/34

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain tin minimal in a dose of alpha rays by alloying tin and lead having an alpha-ray dose not higher than a specific value and then carrying out refining for removing lead contained in tin.

SOLUTION: The dose of alpha ray in lead to be alloyed with tin is regulated to ≤10 cph/cm<SP>2</SP>. When lead having an alpha-ray dose exceeding this value is used, the dose of alpha rays resultant from tin remaining in trace quantities cannot be reduced to ≤0.001 cph/cm<SP>2</SP>. It is desirable to regulate the amount of lead to be alloyed with tin to 0.1 to 99%. After tin and such lead are alloyed, refining for removal of lead contained in tin is performed. By this method, <SP>210</SP>Pb contained in tin can be removed, and as a result, tin minimal in the dose of alpha ray can be produced. To be concrete, tin and lead are melted in a high purity graphite crucible in a nitrogen atmosphere by means of a high frequency induction furnace to form an alloy, and this alloy is introduced into a vacuum distillation apparatus and heated to remove lead by evaporation.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

03/20/2002, EAST Version: 1.03.0002

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-80852

(43)公開日 平成11年(1999) 3月26日

(51)Int.Cl.6	識別記号	FI
C 2 2 B 25/0	8	C 2 2 B 25/08
B23K 35/4	340	B 2 3 K 35/40 3 4 0 Z
// C23C 14/3	4	C 2 3 C 14/34 A
		審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 4 頁
(21)出願番号	特顯平9-236883	(71)出願人 000006264 三菱マテリアル株式会社
(22)出顧日	平成9年(1997)9月2日	東京都千代田区大手町1丁目5番1号
		(72)発明者 大村 豪政
		兵庫県三田市テクノパーク12ー6 三菱マ
		テリアル株式会社三田工場内
	·	(72)発明者 牧 一誠
		兵庫県三田市テクノパーク12ー6 三菱マ
		テリアル株式会社三田工場内
		(74)代理人 弁理士 富田 和夫 (外1名)

(54) 【発明の名称】 低α線量錫の製造方法

(57)【要約】

【課題】 低α線量錫の製造方法を提供する。

【解決手段】 錫とα線量が10cph/cm²以下の鉛を合金化した後、錫に含まれる鉛を除去する精錬を行う。

10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 錫とα線量が10cph/cm²以下の 鉛を合金化した後、錫に含まれる鉛を除去する精練を行 うことを特徴とする低α線量錫の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、a線量の極めて 少ない低α線量錫の製造方法に関するものであり、特に 電子部品を製造するための、はんだ、スパッタリングタ ーゲットまたは化学蒸着材料などの原料として用いるα 線量が0.0005cph/cm² 未満の低α線量錫の 製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】一般に、錫は、はんだの原料であること は知られており、はんだは半導体メモリーにおけるチッ プと基板の接合など半導体装置の製造に使用されてい る。これら半導体装置は、近年、ますます高密度化およ び高容量化する傾向にあり、それに伴って、はんだから 放射されるα線がソフトエラーの発生に大きな影響を及 ぼすようになってきた。そのため、半導体装置の製造に 20 使用されるはんだはα線量が少ないものが望まれてお り、はんだの原料となる錫についても低α線量の錫が求 められている。

【0003】低α線量錫を得る方法として、(a)9 9.95重量%以上の品位を有する錫をアノードとし、 電解液としてSn:30~150g/1、放射性同位元 素をほとんど含有しないスルファミン酸:30~200 g/1を用い、カソード電流密度: 0.5~2.0Am p/d m²、液温度:15~50℃の条件で電解を行う 方法(特公昭62-1478号公報参照)、(b)JI S-K 8951に規定される試薬特級硫酸の規格に適 合する濃硫酸を用いて作製された50~280g/1の 硫酸電解液中で、品位が99.90重量%以上である錫 を陽極に用いて電解を行う方法(特開平1-28339 8号公報参照)などが知られている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、これらの方法 で得られた錫のα線量は十分に低くはなく、例えば、前 記(a)の電解により得られた錫の α 線量は0.2cph/c m²以下であり、さらに(b)の電解により得ら れた錫のα線量は0.03cph/cm²以下であっ て、現在のところ、錫のα線量を0.001cph/c m² 以下に下げることのできる技術はなく、なお一層の 低α線量の錫が求められていた。

[0005]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者らは、 従来よりも一層の低α線量錫を得るべく研究を行った結 果、(イ)通常の錫から放射されるα線源は、不純物と して含まれるPbの内の放射性核種である210 Pbの孫 核種²¹⁰ Poがほとんどである、(ロ) 前記²¹⁰ Pbの 50 れ、これを真空蒸留装置に装入し、10⁻³Torrの真

含有量の少ない錫は、通常の錫にα線量が10cph/ c m² 以下の鉛を合金化して錫ー鉛合金を製造した後、 得られた錫-鉛合金を各種の方法(たとえば、従来の前 記(a)または(b)の方法)で精製すると、合金化し たPbを除去することができるだけでなく、210 Pbを も除去することができ、従来よりも一層α線量の少ない 低α線量錫を得ることができる、などの研究結果が得ら れたのである。

2

【0006】この発明は、かかる研究結果に基づいて成 されたものであって、(1)錫と α 線量が10cph/cm² 以下の鉛を合金化した後、錫に含まれる鉛を除去 する精練を行う低α線量錫の製造方法、に特徴を有する ものである。

【0007】錫と合金化する鉛のα線量を10cph/ cm² 以下としたのは、錫と合金化する鉛のα線量が1 Ocph/cm² を越える鉛を使用すると、極微量残留 した鉛によるα線量が0.001cph/cm²以下に 下げることができなくなるところから、錫と合金化する 鉛のα線量を10cph/cm²以下と定めた。

【0008】その際、錫と合金化する鉛の量は、0.1 ~99%の範囲内にあることが好ましい。したがって、 この発明は、(2) 錫とα線量が10cph/cm²以 下の鉛を0.1~99%の範囲内で合金化した後、錫に 含まれる鉛を除去する精練を行う低α線量錫の製造方 法、に特徴を有するものである。

【0009】この発明で錫とα線量が10cph/cm 2 以下の鉛を合金化した後、錫に含まれる鉛を除去する 精錬を行うと従来よりも低α線量の錫が得られる理由と して、錫と合金化した鉛を除去する精練を行うことによ り、 錫に含まれている²¹⁰ Pbを除去することができ、 α線量の低い錫を作製することができたものと考えられ

【0010】錫のα線源が主に²¹⁰ Pbであるが、²¹⁰ Pb量を直接測定することは難しい。従って、一般に、 210 Pbから放射されるα線は、210 Pb (β崩壊)→ ²¹⁰Bi (β崩壊)→²¹⁰ Po (α崩壊)→²⁰⁶ Pbの ごとく崩壊する過程で210 Poがα崩壊して206 Pbに なる際に放射されるところから、錫中の210 Po量を分 析により正確に測定し、この210 Po量の測定値により 錫に含まれる210 Pb量を評価している。 40

[0011]

【発明の実施の形態】表面α線量が5cph/cm²、 純度:99.99%の市販のSnと、表面α線量が10 cph/cm²、純度:99.99%の市販のPbを用 意し、SnとPbを窒素雰囲気中、高純度黒鉛ルツボ内 で高周波誘導炉で溶解し、Sn-5wt%Pb合金を製 造した。

【0012】実施例1

前記Sn-5wt%Pb合金を高純度黒鉛ルツボに入

空雰囲気中、900℃で10時間加熱した。この真空蒸留装置は、ルツボの設置場所の真上に水で冷却された捕集傘が設置されており、蒸発したPbは捕集傘内で凝固し、Pbが除去される。冷却後、高純度黒鉛ルツボ内に残留したSnを取り出し、これを原料として同様に再度真空蒸留したSnを1mmの厚さに圧延し、Sn板を作製した。

【0013】このSn板を3年経過させた後、この合金板の4000cm²を試料とし、表面α線量を(株)住化分析センター製(LACS-4000M、測定下限: 0.0005cph/cm²)で96時間測定した。この装置の測定下限は0.0005cph/cm²であり、この装置では表面α線量を測定することができなかったところから、表面α線量は0.0005cph/cm²未満であることが分かり、その結果を表1に示した。

【0014】さらに、この3年経過させたSn板:3gを試料とし、これを熱塩酸で溶解した液に、208 Po溶液を1dpm(decay/min)添加し、0.5モルHC1溶液に調整した後、銀板を6時間浸漬し、208 Poを銀板表面に電着させ、この銀板をシリコン表面障壁型α線測定装置(SSB、測定面積:70cm²、定量下限:0.01cph/cm²)を用いて、α線スペクトルを7日間測定し、トレーサー208 Poの量から210 Poを測定した。この分析方法の定量下限は2dpm/kgであり、この装置では210 Poを測定することができなかったところから、試料の210 Po量は2dpm/kg未満であることが分かり、その結果を表1に示した。

【0015】さらに、この3年経過させたSn板を試料とし、これを熱塩酸に溶解し、得られた液をICP(プラズマ発光分光分析装置、定量下限:1ppm)で分析し、不純物Pb量を測定し、その結果を表1に示した。【0016】なお、表面α線量および²¹⁰ Po量の測定を精練後3年経過後の試料で行うのは、精練によりSn中の主放射性核種である²¹⁰ Poが減少し、見掛上α線量が減少する現象が存在するためであり、²¹⁰ Poの親核種である²¹⁰ Pbが壊変し、²¹⁰ Poが放射平衡に達するのに約2.3年かかり、3年経過後に測定すれば、α線量も²¹⁰ Poも真の値を測定することができるからである。

【0017】 従来例1

市販のSnを単独で高純度黒鉛ルツボに入れ、これを真空蒸留装置に装入し、10⁻³Torrの真空雰囲気中、900℃で10時間加熱することを2度繰り返すことにより、実施例1と同様にPbを蒸発させ、蒸発したPb

4

は捕集傘内で凝固し、Pbを除去し、冷却後、高純度黒鉛ルツボ内に残留したSnを取り出し、1mmの厚さに圧延することによりSn板を作製し、実施例1と同様に3年経過後の表面α線量、²¹⁰ Poおよび不純物Pb量を測定し、その結果を表1に示した。

【0018】実施例2

前記高純度黒鉛ルツボ内で高周波誘導炉で溶解して得られたSn-1wt%Pb合金をアノードとし、

液組成: Sn: 30g/1、スルファミン酸: 196g10 /1

カソード電流密度:2.0A/dm3、

液温:35℃、

の条件で電解することによりPbを除去し、カソードにSnを析出させ、カソードのSnを実施例1と同様に圧延して得られたSn板の3年経過後の表面 α 線量、 210 Poおよび不純物Pb量を実施例1と同様に測定し、その結果を表1に示した。

【0019】従来例2

市販のSnをアノードとし、実施例2と同じ条件で電解 20 することによりPbを除去し、カソードにSnを析出させ、カソードのSnを実施例1と同様に圧延して得られたSn板の3年経過後の表面α線量、210 Poおよび不純物Pb量を実施例1と同様に測定し、その結果を表1に示した。

【0020】実施例3

電解液として、JIS-K 8951に規定される試薬特級硫酸と高純度純水を用い、酸濃度:250g/lの硫酸を作製し、これにゼラチン:2g、βナフトール:2gを添加した溶液を用意した。この電解液を用い、前記高純度黒鉛ルツボ内で高周波誘導炉で溶解して得られたSn-1wt%Pb合金をアノードとし、ステンレス板をカソードとし、電流密度:0.8A/dm³、液温:45℃、の条件で電解することによりカソードにSnを析出させ、カソードのSnを実施例1と同様に圧延して得られたSn板の3年経過後の表面α線量、210 Poおよび不純物Pb量を実施例1と同様に測定し、その結果を表1に示した。

【0021】従来例3

市販のSnをアノードとし、実施例3と同じ条件で電解 40 することによりカソードにSnを析出させ、カソードの Snを実施例1と同様に圧延して得られたSn板の3年 経過後の表面α線量、²¹⁰ Poおよび不純物Pb量を実 施例1と同様に測定し、その結果を表1に示した。

[0022]

【表1】

7	בונו ני	1	 U	v	U	_

6

			精錬した鍋の3年経過後の測定値				
種	別	科	α線量 (cph/c m²)	310 Po虽 (dpm/kg)	不純物Pb量 (ppm)		
	1	Sn—1wt紹合金	<0. 0005	<2	3		
実施	2		<0.0005	<2	4		
例	3		<0.0005	<2	2		
	1	0.71	3. 5×10 ⁸	1			
従来	2	市販のSn	1. 43	7. 0×10 ³	1		
例	3		0. 24	1. 2×10 ^a	1		

[0023]

そのまま単独で精錬する従来例1~3により得られたS nに含まれる不純物Pb量は、市販のSnに表面α線量 が10cph/cm²以下の高純度Pbを合金化したS n-Pb合金を精錬する実施例1~3により得られたS nに含まれる不純物Pb量よりも少いにもかかわらず、 実施例1~3により得られたSnのα線量および210 P ο量は従来例1~3により得られたSnのα線量および*

*210 Po量よりも格段に少ないことが分かる。実施例1 【発明の効果】表 1 に示される結果から、市販のSnを 20 \sim 3 のSn中の α 線の放出源である 210 Poの減少は、 Sn中の210 Pbが合金化したPbに希釈され、Pb除 去を目的とした精錬後には、Sn中の210 Pbが極端に 減少していることを示しているものである。上述のよう に、この発明の方法によると、α線量の極めて少ない錫 を製造することができ、産業上倒れた効果を奏するもの である。